SPECIFICATION TRANSISTORS, DIODES

NO. 17 - 2T-1323

PAGE: 2/20/173

2 S C 1 4 7 5

暫 定



GAIN GROUPS -

2, 3, 4 2 our

option 10K D. 20 30 Days from D.O.a.

DATE:

1. 構造 NPN・APM形・エピタキシャル・シリコン・トランジスタ

2. 用 途 低周波~高周波電力増巾,スイッチング

3. 外 形 付図参照

4. 絶対最大定格 (Ta-25℃)

コレクタ・エミッタ 間電圧 エミッタ・ベース間 電圧 コ レ ク タ 電 流

コレクタ・ベース間 電圧

ベース電流 コレクタ損失

ジャンクション温度

保 存 温 度

V_{CBO} 1.00V

 $egin{array}{ccc} V_{ ext{CEO}} & & 5 0 V \\ V_{ ext{EBO}} & & 6 V \end{array}$

I C 1 A 0.5 A 0.5 A

P_C 7 5 0 mW 1 5 0 °C

 $T_{stg} = -50^{\circ}C + 150^{\circ}C$

5. 電気的特性 (Ta=25°C)

項目	記号	条 件	最小值	標準値	最大值	単位
コレクタ遮断電流	I _{CBO}	V_{CB} =25V, I_{E} =0			0.2	$\mu_{\mathbf{A}}$
エミツタ遮断電流	I _{EBO}	V _{EB} =6V, I _C =0			0.2	иA
ベース・エミッタ電圧	$V_{ m BE}$	V _{CE} =6V, I _C =5mA			0.70	V
コレクタ・エミツタ電圧	V _{CEO} (s u s)	I _C =2mA	50		•	V
コレクタ・エミツタ 飽 和 電 圧	VCE(s a t)	$I_{C}=1$ A, $I_{B}=5$ 0 mA			0.3	V
ベース・エミツタ 飽和電圧	VBE(sat)				1.0	·V.
直流電流増巾率	hFE1	V _{CE} =2V, I _C =100mA	98		649	
直流電流增巾率	hFE2	V _{CE} =1 V, I _C =1 A	7.0			
小信号電流増巾率	h _{f e}	V_{CB} =2V, I_E =10mA, f =10 MHz		18		dB
コレクタ出力容量	СС	V_{CB} =10V, I_{E} =0A, f =1 Mz		16	40	pF
熱 抵 抗	θ _{j-a}				126	·C/W

ributor

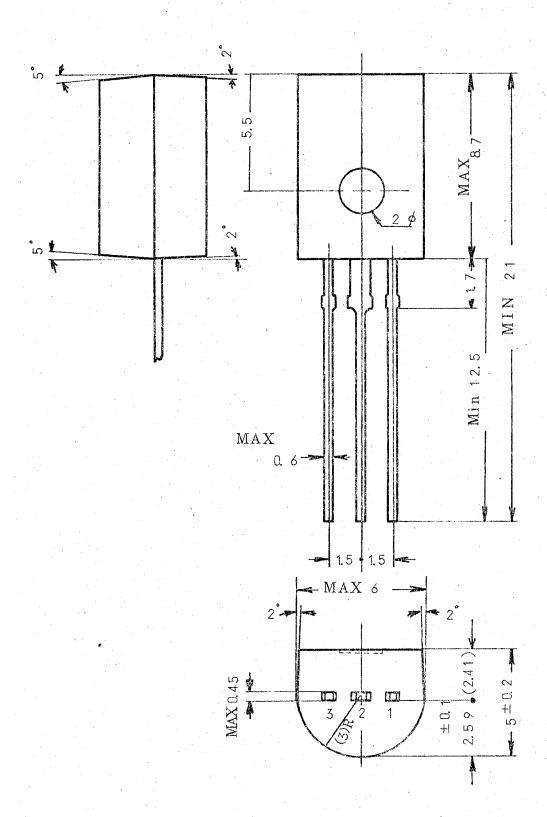
TOSEL CO

INC

規格細分

6.

	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	h _{FE1} (^V CE=2V, ^I C=100 mA)			
		最小値	最大值		
	.1	98	156		
	2	1 4 0	222		
	3	199	3 1 6		
	4	285	451		
The second secon	5	409	6 4 9.		



5 / 1